

D25XB

800V 25A

特長

- 薄型 SIP パッケージ
- UL E142422
- 大電流容量
- 高耐圧・高 I_{FSM}
- 高放熱伝導性

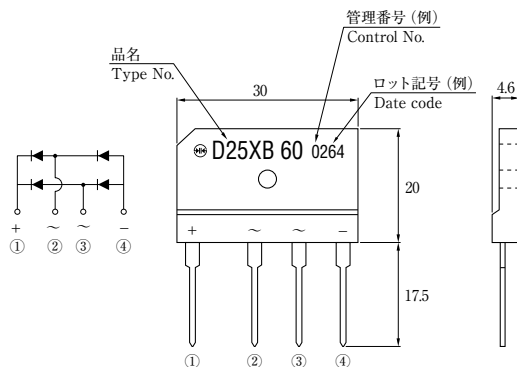
Feature

- Thin-SIP
- UL E142422
- Large I_o
- High Voltage・Large I_{FSM}
- High Thermal Radiation

■外観図 OUTLINE

Package : 5S

Unit : mm
Weight : 7.1g (typ.)



外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

■定格表 RATINGS

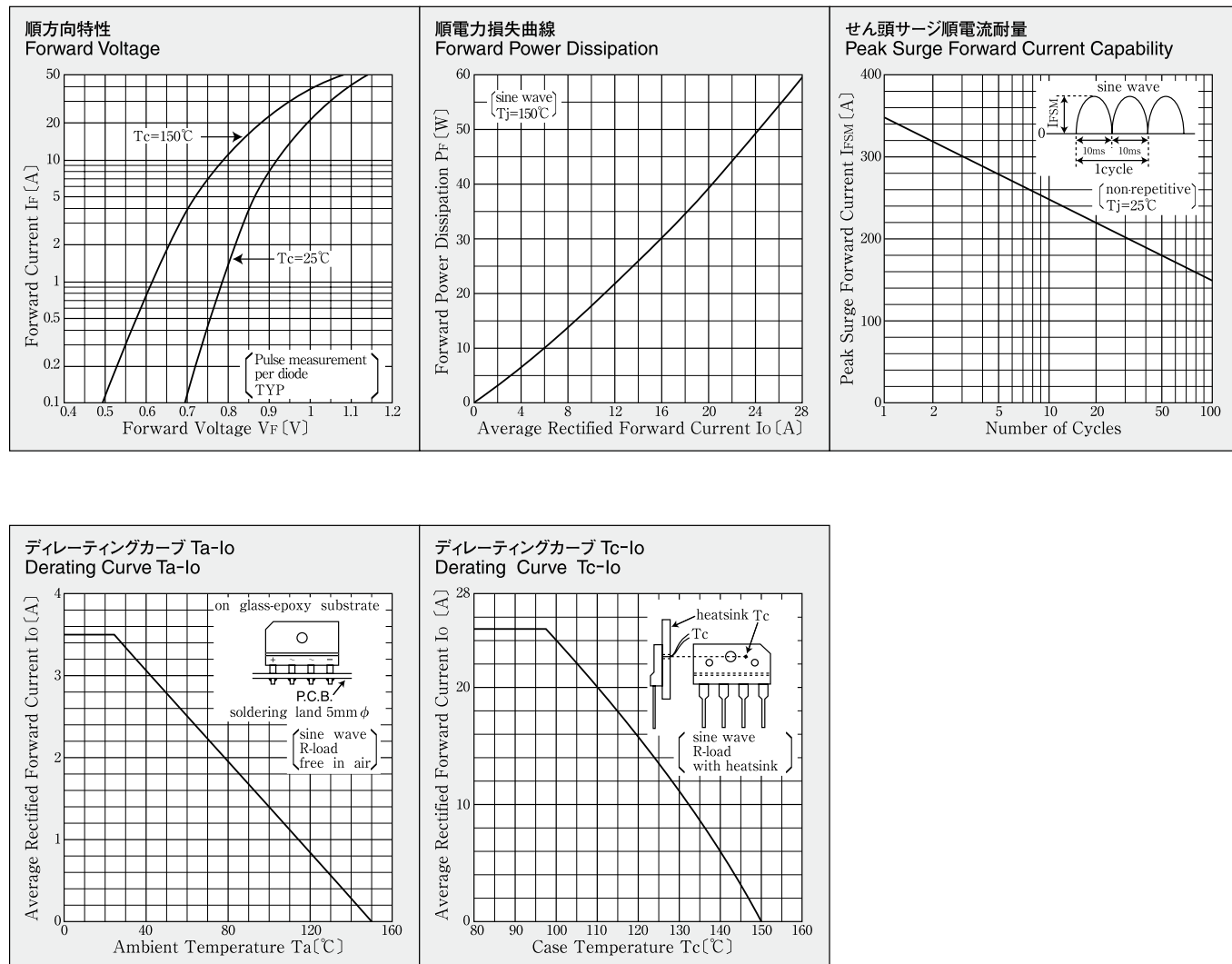
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_c=25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

項 目 Item	記号 Symbol	条 件 Conditions		品 名 Type No.	D25XB20	D25XB60	D25XB80	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T _{stg}				- 40～150			℃
接合部温度 Operation Junction Temperature	T _j				150			℃
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}				200	600	800	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	フィン付き With heatsink	T _c = 98℃	25			A
			フィンなし Without heatsink	T _a = 25℃	3.5			
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1 サイクルせん頭値, T _j = 25℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, T _j = 25℃			350			A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I ² t	1ms ≤ t < 10ms, T _j = 25℃, 1 素子当たりの規格値 per diode			300			A ² s
絶縁耐圧 Dielectric Strength	V _{dis}	一括端子・ケース間, AC 1 分間印加 Terminals to Case, AC 1 minute			2.5			kV
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値 : 0.5 N・m) (Recommended torque : 0.5 N・m)			0.8			N・m

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_c=25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V_F	$I_F=12.5\text{A}$, パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 1.05	V
逆電流 Reverse Current	I_R	$V_R=V_{RM}$, パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θ_{jc}	接合部・ケース間, フィン付き Junction to Case, With heatsink	MAX 1	$^\circ\text{C}/\text{W}$
	θ_{jl}	接合部・リード間, フィンなし Junction to Lead, Without heatsink	MAX 5	
	θ_{ja}	接合部・周囲間, フィンなし Junction to Ambient, Without heatsink	MAX 22	

特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- * Sine wave は 50Hz で測定しています。
- * 50Hz sine wave is used for measurements.
- * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
Typical は統計的な実力を表しています。
- * Semiconductor products generally have characteristic variation.
Typical is a statistical average of the device's ability.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9